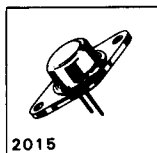


2SD315

2SB509

低周波電力増幅用



2015

Mesa Type Silicon Transistor
For AF Power Amplifier Use

★ A complementary pair.

⊖ C444

- ・ 20~30 W の低周波パワーアンプ出力段用に最適。これらはコンプリメンタリペアを組むことができる。
- () 内は 2SB509 の場合を示す。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	(-)60	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	(-)60	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	(-)5	V
コレクタ電流	I_C	(-)4	A
ピークコレクタ電流	i_{cp}	(-)10	A
コレクタ損失	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-40~+150	$^\circ\text{C}$

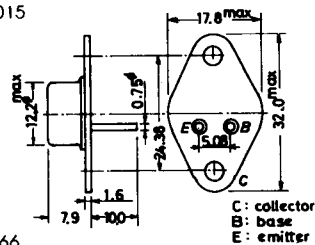
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=(-)20\text{V}, I_E=0$		(-)0.1		mA
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=(-)4\text{V}, I_C=0$		(-)1.0		mA
二次降伏電圧	$V_{S/B}$	$I_C=(-)0.5\text{A}, t=1\text{sec}$	(-)60			V
直流電流増幅率	$\times h_{FE}(1)$	$V_{CE}=(-)2\text{V}, I_C=(-)1\text{A}$	$\times 40$		$\times 320$	
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE}=(-)2\text{V}, I_C=(-)0.1\text{A}$	40			
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)0.5\text{A}$		8		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=(-)2\text{A}, I_B=(-)0.2\text{A}$	(-)0.4	(-)1.0		V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$I_C=(-)1\text{A}, V_{CE}=(-)2\text{V}$		(-)1.5		V

※ 2SB509, 2SD315 は 2V 1A h_{FE} により次のように分類している。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2015
(unit: mm)



JEDEC TO-66